

应用



步 励磁

$I_{T(AV)}$	200A
V_{RRM}	100-1600V
I_{TSM}	2836A
I^2t	163 KA ² s

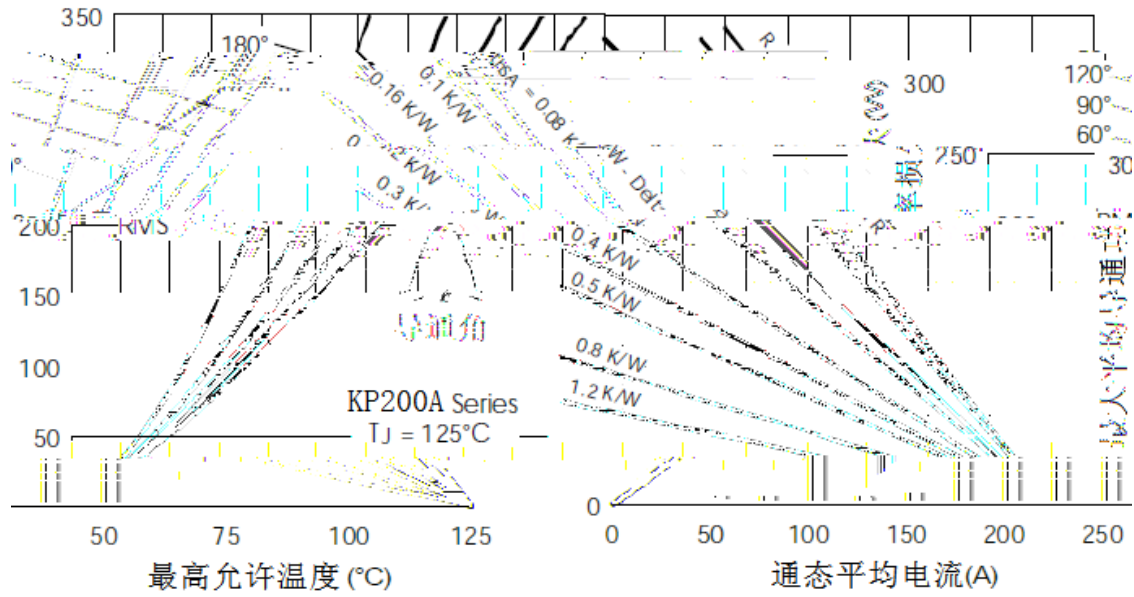
额定电压

	V_{DRM}/V_{RRM}	V_{RSM}	I_{DRM}/I_{RRM} T _J T _J mA

状态条件

$I_{T(AV)}$				正弦半波	
T _C					
$I_{T(RMS)}$					
I_{TSM}				V_{RRM}	T _J T _J
I^2t	浪涌电流平方时间积		KA ²	V_{RRM}	T _J T _J
V _{T(TO)1}				$I_{T(AV)}$	$I_{T(AV)}$ T _J T _J
V _{T(TO)2}				$I_{T(AV)}$	T _J T _J
R _{t1}			mΩ	$I_{T(AV)}$	$I_{T(AV)}$ T _J T _J
R _{t2}				$I_{T(AV)}$	T _J T _J
V _{TM}				I _{PK}	T _J
I _H					T _J °C, 阳极供应 6V,电阻负载
I _L					

di/dt	通态电流临界上升率	*&	T_J	T_J	V_{DM}	V_{DRM}	t_q	$6\mu s$,
t_{qt}	间		T_J	$^{\circ}C$	$A_t = V_{DRM}/V_{RRM}, T_J$			
t_{rr}	恢 间	&	T_J	T_J	I_{TM}	$I_{T(AV)}$	$t_q > 200\mu s$	+**+ % *&
t_q	关 间		T_J	T_J	I_{TM}	$I_{T(AV)}$	$t_q > 200\mu s$	V_R
dv/dt	断态电压临界上升率	*&	T_J	T_J	$V_{DM} = 67\%$	V_{DRM}	栅偏 % -	
I_{DRM}, I_{RRM}	状 泄漏		V_{DM}	V_{RRM}	$\$ 0\$ 1+ V_{DRM}/V_{RRM} \$ 22^*1+$			
P_{GM}	栅极功	-	T_J	T_J	$\$$			
$P_{G(AV)}$	栅极功	-	T_J	T_J	$\$$			
I_{GM}	栅极		T_J	T_J	$\$$			
$4V_{GM}$			V					
$-V_{GM}$			V					
I_{GT}	直 栅极 需要触发	mA	T_J	$\%$	$^{\circ}C$			
			T_J	$^{\circ}C$				
			T_J	$^{\circ}C$				
V_{GT}	直 栅极 需要触发		T_J	$\%$	$^{\circ}C$			
			T_J	$^{\circ}C$				
I_{GD}	直 栅极 触发	mA	T_J	T_J	$\$$	V_{DRM}	=额定值	
V_{GD}	直 栅极 触发		T_J	T_J	$\$$	V_{DRM}	=额定值	
T_J	操作 范围	% %						
T_{stg}	存储 范围	% %						
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	*-	直 操作					
$R_{th(c-s)}$	热阻抗(壳至散)	*-	安装表面光滑、 坦 润滑					
.	安装力	5						
W_t	质量	g						



耗特性

Fig. 3 - 通态损

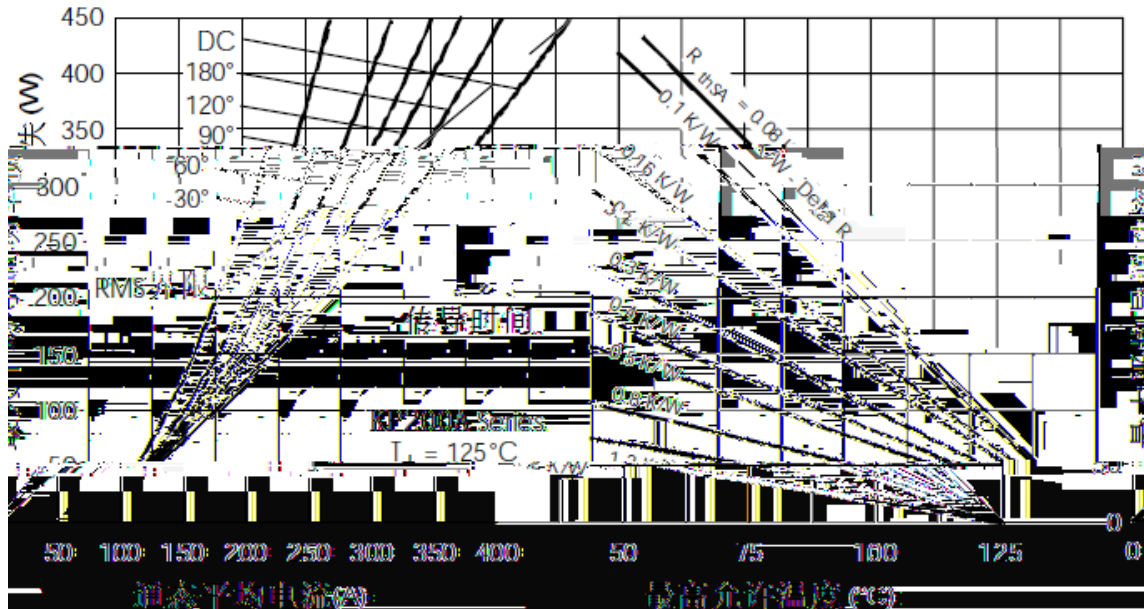
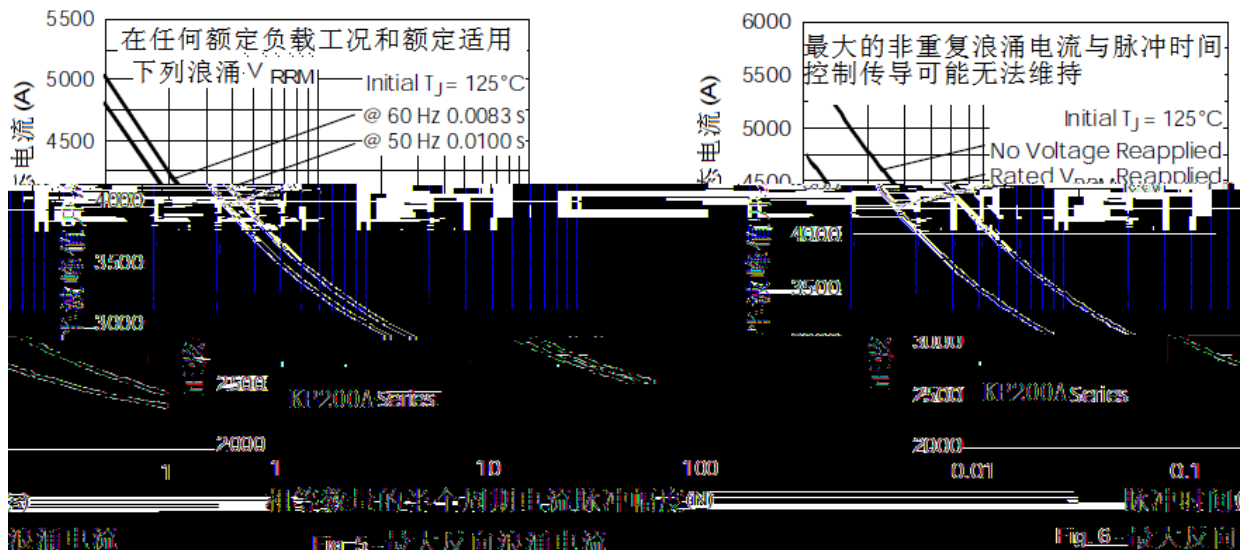


Fig. 4 - 通态损耗特性



! "\$ % & \$ " # ()

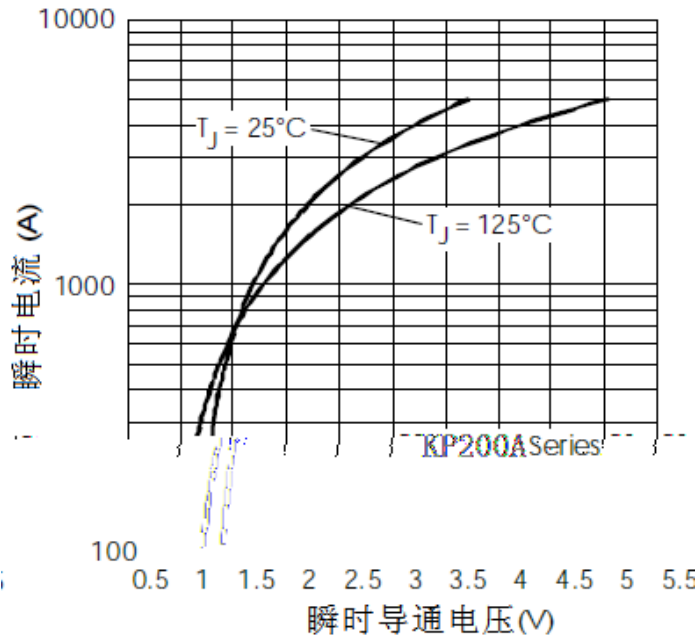
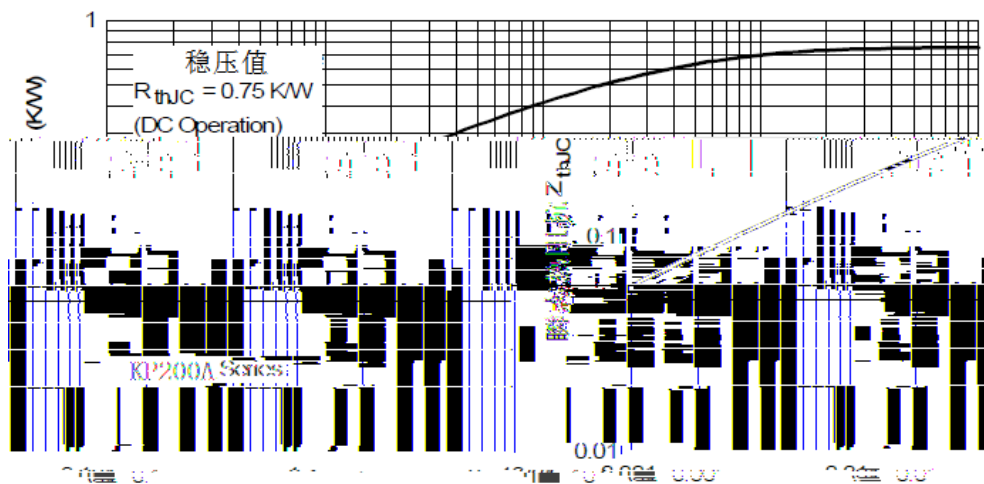


Fig. 7 - 正向压降特性



5 - 热阻抗特性 Z_{thJC}

方: Fig. 14

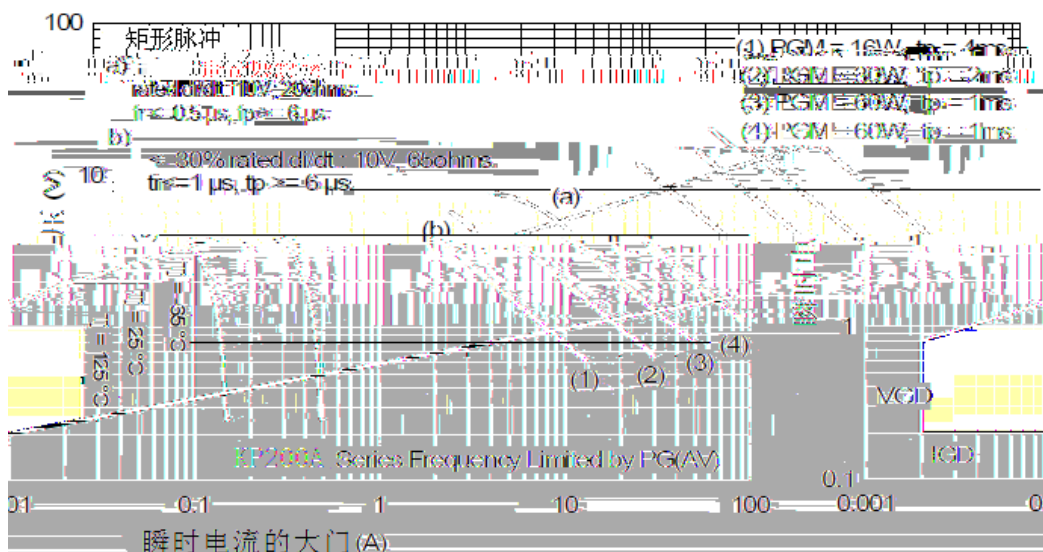
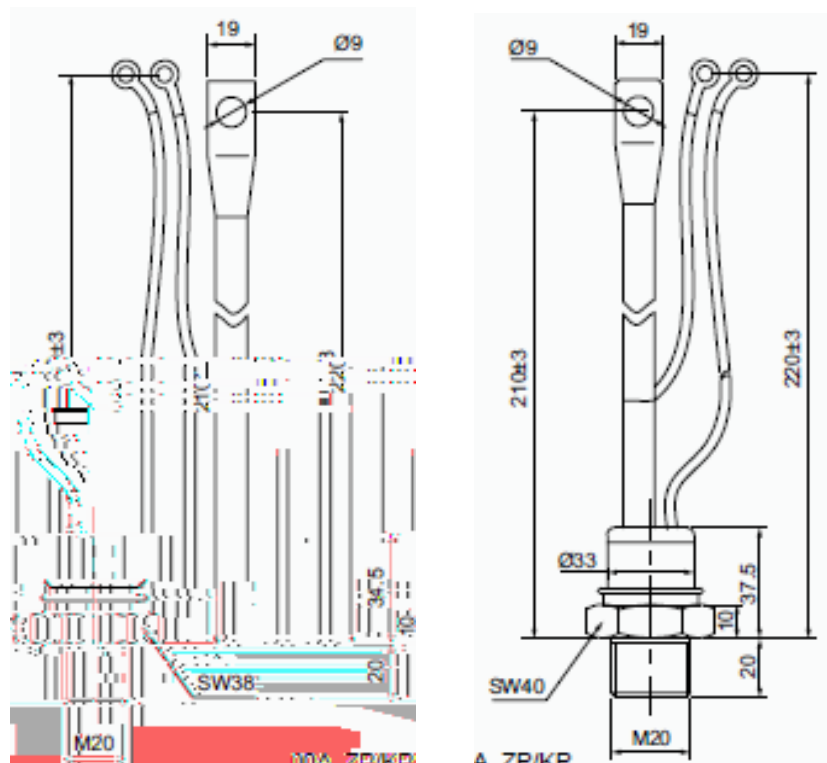


Fig. 16 - 栅极特性

外形图:



图